



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104183720 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 03

(21) 申请号 201310193565. 1

(22) 申请日 2013. 05. 22

(71) 申请人 海洋王照明科技股份有限公司

地址 518052 广东省深圳市南山区南海大道
海王大厦 A 座 22 层

申请人 深圳市海洋王照明技术有限公司
深圳市海洋王照明工程有限公司

(72) 发明人 周明杰 冯小明 陈吉星 王平

(74) 专利代理机构 深圳中一专利商标事务所
44237

代理人 张全文

(51) Int. Cl.

H01L 51/50 (2006. 01)

H01L 51/52 (2006. 01)

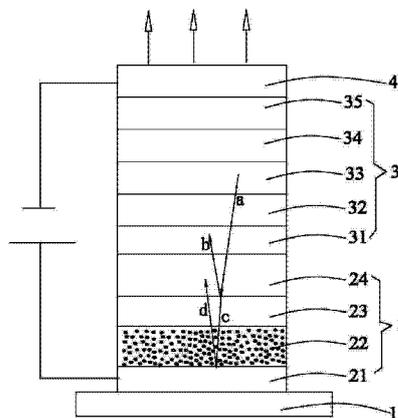
权利要求书1页 说明书10页 附图2页

(54) 发明名称

有机电致发光装置、显示屏及其终端

(57) 摘要

本发明公开了一种有机电致发光装置、显示屏及其终端。该有机电致发光装置,包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层,所述阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、散射层、干涉层、半透金属层;其中,所述散射层材料包括透明导电氧化物和掺杂于所述透明导电氧化物中的金属粒子,所述干涉层材料为透明导电氧化物。本发明有机电致发光装置的阳极有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率,提高了其的对比度。含有该有机电致发光装置的显示屏及其终端具有高对比度,其显示画面清晰。



1. 一种有机电致发光装置,包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层,所述有机功能层包括在外加电源的驱动下发光的发光层,其特征在于:所述阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、散射层、干涉层、半透金属层,所述金属反射层与基板层叠结合,所述半透金属层与有机功能层层叠结合;其中,所述散射层材料包括透明导电氧化物和掺杂于所述透明导电氧化物中的金属粒子,所述干涉层材料为透明导电氧化物。

2. 如权利要求 1 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述散射层材料中的透明导电氧化物和干涉层材料透明导电氧化物为相同或不不同的铟锡氧化物薄膜、铟锌氧化物、或铝锌氧化物、镓锌氧化物中的至少一种。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述散射层材料中的金属粒子掺杂量占散射层总重量的 9.1% ~ 16.7%,所述金属粒子为 Ag、Cr、Ni、Pt、Cu 中的至少一种。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述散射层的厚度为 10nm ~ 20nm。

5. 如权利要求 1 或 2 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述干涉层的厚度为 60nm ~ 80nm。

6. 如权利要求 1 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述金属反射层的厚度为 70nm ~ 200nm。

7. 如权利要求 1 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述半透金属层厚度为 5nm ~ 10nm。

8. 如权利要求 1 或 6 或 7 所述的有机电致发光装置,其特征在于:所述金属反射层材料或 / 和半透金属层材料为金属 Ag、Al、Au、Ni、Cr 中的任一种或两种以上的合金。

9. 一种显示屏,包括显示模块和用于控制显示模块的控制模块,其特征在于:所述显示模块含有如权利要求 1 ~ 8 任一项所述的有机电致发光装置。

10. 一种设有显示屏的终端,所述终端的显示屏为如权利要求 9 所述的显示屏。

有机电致发光装置、显示屏及其终端

技术领域

[0001] 本发明属于电光源技术领域，具体的说是涉及一种有机电致发光装置、显示屏及其终端。

背景技术

[0002] 有机电致发光器件(Organic Light Emission Diode,以下简称OLED)是基于有机材料的一种电流型半导体发光器件。其典型结构是在ITO玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极。

[0003] OLED的发光原理是基于在外加电场的作用下,电子从阴极注入到有机物的最低未占有分子轨道(LUMO),而空穴从阳极注入到有机物的最高占有轨道(HOMO)。电子和空穴在发光层相遇、复合、形成激子,激子在电场作用下迁移,将能量传递给发光材料,并激发电子从基态跃迁到激发态,激发态能量通过辐射失活,产生光子,释放光能。

[0004] OLED具有发光效率高、材料选择范围宽、驱动电压低、全固化主动发光、轻、薄等优点,同时拥有高清晰、广视角、响应速度快、低成本以及色彩鲜艳等优势,是一种极具潜力的显示技术和光源,符合信息时代移动通信和信息显示的发展趋势,以及绿色照明技术的要求,因此,被业内人士认为是最有可能在未来的照明和显示器件市场上占据霸主地位的新一代器件。作为一项崭新的照明和显示技术,OLED技术在过去的十多年里发展迅猛,取得了巨大的成就。由于全球越来越多的照明和显示厂家纷纷投入研发,大大的推动了OLED的产业化进程,使得OLED产业的成长速度惊人,目前已经到达了大规模量产的前夜。

[0005] 但现有的OLED器件的阴极一般是使用高反射率的金属阴极材料,具体地,该高反射率的金属阴极材料制备成的高反射率的金属阴极在可见光段具有超过90%的反射率,因此该如此高反射率阴极却给OLED在显示器件上的应用带来阻碍。这是因为,作为显示器件,高对比度是人们长期的追求,对屏幕对比度的要求更高,如果将现有高反射率阴极的OLED器件在显示器件上的应用时,在太阳光照射下,由于其高反射率阴极的高反射率作用,使得显示器件的对比度低,显示的内容无法看清。因此,将OLED器件在显示器中应用时,如何降低OLED器件的反射率是待解决的技术难题。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于克服现有技术的上述不足,提供一种阳极具有低反射率的有机电致发光装置。

[0007] 本发明的另一目的在于提供一种对比度高的显示屏。

[0008] 本发明的又一目的在于提供一种含有上述显示屏的终端。

[0009] 为了实现上述发明目的,本发明的技术方案如下:

[0010] 一种有机电致发光装置,包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层,所述有机功能层包括在外加电源的驱动下发光的发光层,所述阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、散射层、干涉层、半透金属层,所述金属反射层与基板层叠结

合,所述半透金属层与有机功能层层叠结合;其中,所述散射层材料包括透明导电氧化物和掺杂于所述透明导电氧化物中的金属粒子,所述干涉层材料为透明导电氧化物。

[0011] 以及,一种显示屏,包括显示模块和用于控制显示模块的控制模块,其中,所述显示模块含有如上述的有机电致发光装置。

[0012] 以及,一种设有显示屏的终端,所述终端的显示屏为上述含有有机电致发光装置的显示器。

[0013] 上述有机电致发光装置通过将阳极设置成依次层叠结合的金属反射层、散射层、干涉层、半透金属层结构,有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率,提高了其的对比度。其中,半透金属层能对由从阴极层端入射光起了半透半反射的作用;干涉层能对由半透金属层折射的光产生干涉,使其再次发生折射,散射层不仅能对由干涉层入射的光发生干涉作用,其中的金属粒子对入射光发生散射作用,因此,该干涉层与散射层协同作用,使半透金属层反射光与金属反射层反射光的相位相反,达到干涉相消的效果,有效减少了光总的反射,实现低的反射率。

[0014] 上述显示屏由于含有上述有机电致发光装置,因此其具有高对比度,其显示画面清晰。由于设有显示屏的终端含有该高对比度的显示屏,因此该终端的显示屏画面清晰。

附图说明

[0015] 图1为本发明实施例有机电致发光装置结构示意图;

[0016] 图2为本发明实施例有机电致发光装置另一优选结构示意图;

[0017] 图3为本发明实施例有机电致发光装置制备方法的流程示意图。

具体实施方式

[0018] 为了使本发明要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例与附图,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0019] 有机电致发光像素对比度 = (器件发光亮度(开) + 器件反射的环境光亮度) / (器件发光亮度(关) + 器件反射的环境光亮度),根据这个计算方法,在透明阳极的OLED器件中,提高对比度的方法之一就是降低器件对环境的光反射,也就是降低反射电极的反射率。

[0020] 基于上述理论,本发明实施例采用降低阳极反射率的途径来提高有机电致发光像素对比度。因此,本发明实施例提供了一种阳极具有低反射率的有机电致发光装置,其结构如图1至图2所示。该有机电致发光装置包括依次层叠结合的基板1、阳极层2、有机功能层3和阴极层4。

[0021] 具体地,上述基板1的材料为玻璃、聚合物薄膜材料等,如普通玻璃、聚合物薄膜材料基底等。当然,基板1的材料还可采用本领域其他材料进行替代。基板1的厚度也可以采用本领域常用的厚度或者根据应用的要求进行灵活选用。

[0022] 上述阳极层2包括依次层叠结合的金属反射层21、散射层22、干涉层23和半透金属层24,其中,金属反射层21与基板1层叠结合,半透金属层24与有机功能层3层叠结合。该结构的阳极层2中的半透金属层24能对由从阴极层4端入射光起了半透半反射的作用,散射层22、干涉层23不仅具有良好的导电性,能使空穴注入,更重要的是能对半透金属层

24 反射光与金属反射层 21 反射光的相位相反,达到干涉相消的效果,有效减少了光总的反射,实现低的反射率。其中,该干涉层 23 对由半透金属层折射的光产生干涉,使其再次发生折射,散射层不仅能对由干涉层入射的光发生干涉作用,其中的金属粒子还能对入射光发生散射作用,因此,该干涉层 23 与散射层 22 协同作用对入射光产生干涉作用。具体地,从阴极层 4 端射向该结构的阳极层 2 的光线反射和折射如图 1、2 中所示,环境光线 a 从外部入射时,在半透金属层 24 表面发生第一次反射和折射,形成反射光线 b,折射光线 c 依次经过干涉层 23、散射层 22 之间的协同干涉作用后,入射至金属反射层 21 表面并发生反射,形成反射光线 d。该发射光线 b、反射光线 d 形成光线的干涉相消效应,削弱阳极层 2 产生的反射光,从而有效降低阳极层 2 的反射率。

[0023] 其中,该半透金属层 24 能使由阴极层 4 端入射来的光在其界面发生部分透过部分反射。为了更好的调节光线的反射和透过率,作为优选实施例,该半透金属层 24 的厚度为 5nm ~ 10nm。作为另一优选实施例,该半透金属层 24 的材料为 Ag、Al、Au、Ni、Cr 中的任一种或两种以上的合金。应该理解,只要能实现该半透金属层 24 部分透过部分反射的其他厚度和其他能做阴极金属材料也属于本发明限定的范围。

[0024] 该散射层 22 材料包括透明导电氧化物和掺杂于透明导电氧化物中的金属粒子,干涉层 23 材料为透明导电氧化物。在优选实施例中,该散射层 22 材料中的透明导电氧化物和干涉层 23 材料透明导电氧化物为相同或不不同的铟锡氧化物薄膜(ITO)、铟锌氧化物(IZO)、或铝锌氧化物(AZO),镓锌氧化物(GZO)中的至少一种。该优选的透明导电氧化物对光具有合适的干涉作用,掺杂在散射层 22 中的金属粒子还能起到对光的散射作用,实现散射层 22 与干涉层 23 之间对光的协同干涉作用,使得对半透金属层 24 反射光与金属反射层 21 反射光之间的干涉相消的效果好,有效减少了光总的反射,实现低的反射率。另外,该透明导电氧化物成膜导电性好,能有效提高空穴注入能力。

[0025] 为了提高该散射层 22 对光的散射作用,在优选实施例中,该散射层 22 材料中的金属粒子掺杂量占散射层 22 总重量的 9.1% ~ 16.7%。其中,该金属粒子优选为 Ag、Cr、Ni、Pt、Cu 中的至少一种。在另一优选实施例中,该散射层 22 的厚度为 10nm ~ 20nm,该优选厚度对光具有更好的干涉和散射作用。

[0026] 作为优选实施例,该干涉层 23 厚度为 60nm ~ 80nm。通过调节该干涉层 23 厚度实现其对光干涉作用的提高。

[0027] 作为另一优选实施例,散射层 22 的厚度为 10nm ~ 20nm,干涉层 23 厚度为 60nm ~ 80nm。通过同时调节两层的厚度,使得两层协同作用更好,增强两层对光干涉作用。

[0028] 该金属反射层 21 设置的目的是将从散射层 22 传输来的光在其界面发生反射,并将该反射光通过散射层 22、干涉层 23 的传输后与半透金属层 24 界面发生反射的光互相抵消,以降低阳极层 2 的反射率。作为优选实施例,该金属反射层 21 的厚度为 70nm ~ 200nm。作为另一优选实施例,上述金属反射层 21 金属材料为 Ag、Al、Au、Ni、Cr 中的任一种或两种以上的合金。应该理解,只要能实现该金属反射层 21 反光作用的其他厚度和其他能做阳极金属材料也属于本发明限定的范围,如不计成本,该金属反射层 21 的厚度还可以是 200nm 以上。

[0029] 作为上述有机电致发光装置的另一优选实施例,金属反射层 21 的厚度为 70nm ~ 200nm,散射层 22 的厚度为 10nm ~ 20nm,干涉层 23 的厚度为 60nm ~ 80nm 和半透金属层

24 厚度为 5nm ~ 10nm。该优选实施例中各层厚度的组合,能使得金属反射层 21 与半透金属层 24 反射光相抵消的效果更好,使得阳极层 2 有更低的反射率。

[0030] 作为上述有机电致发光装置的再一优选实施例,上述金属反射层 21 和半透金属层 24 材料为 Ag、Al、Au、Ni、Cr 中的任一种或两种以上的合金;散射层 22 材料为上述透明导电氧化物与上述金属粒子掺杂的混合物层,且金属粒子掺杂量占散射层总重量的 9.1% ~ 16.7%;干涉层 23 材料为上述透明导电氧化物。该优选实施例中各层所选用材料的组合,赋予阳极层 2 更低的反射率和空穴注入和传输性能。

[0031] 作为上述有机电致发光装置的又一优选实施例,上述金属反射层 21 的厚度为 70nm ~ 200nm,其材料为金属 Ag、Al、Au、Ni、Cr 中的任一种或两种以上的合金;散射层 22 厚度为 10nm ~ 20nm,其材料为上述透明导电氧化物与上述金属粒子掺杂的混合物层,且金属粒子掺杂量占散射层总重量的 9.1% ~ 16.7%;干涉层 23 厚度为 60nm ~ 80nm,其材料为上述透明导电氧化物;半透金属层 24 厚度为 5nm ~ 10nm,其材料为金属 Ag、Al、Au、Ni、Cr 中的任一种或两种以上的合金。该优选实施例中各层厚度和材料的组合,使得阳极层 2 更低的反射率以及优异的空穴注入和传输性能。

[0032] 上述有机电致发光装置实施例中的有机功能层 3 包括依次层叠结合的空穴注入层 31、空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34、电子注入层 35,且空穴注入层 31 与阳极层 2 的与衬底层 1 相结合面相对的表面层叠结合,电子注入层 35 与阴极层 4 层叠结合,如图 1 所示。

[0033] 在具体实施例中,上述空穴注入层 31 材料可以是 ZnPc(酞菁锌)、CuPc(酞菁铜)、VOPc(酞菁氧钒)、TiOPc(酞菁氧钛)中的至少一种。当然,该空穴注入层 31 材料还可以是本领域常用的其他材料,如 WO_3 、 VO_x 、 WO_x 或 MoO_3 等氧化物,或者无机空穴注入层材料与有机空穴注入层材料的掺杂混合物。空穴注入层 31 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设置。该空穴注入层 31 的设置,能有效增强其与阳极层 2 间的欧姆接触,加强了导电性能,提高阳极层 2 端的空穴注入能力。正因如此,该空穴注入层 31 也可以根据实际的需要不设置,也就是说,空穴传输层 32 可以直接与阳极层 2 直接层叠结合。

[0034] 上述空穴传输层 32 材料可以是 NPB(N,N'-二苯基-N,N'-二(1-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺)、TPD(N,N'-二苯基-N,N'-二(3-甲基苯基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺)、MeO-TPD(N,N,N',N'-四甲氧基苯基)-对二氨基联苯)、MeO-Sprio-TPD(2,7-双(N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基)-9,9-螺二芴)中的至少一种。当然,该空穴传输层 32 材料还可以是本领域常用的其他材料,如 4,4',4''-三(N-3-甲基苯基-N-苯基氨基)三苯胺(m-MTDATA)等。空穴传输层 32 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设置。

[0035] 上述发光层 33 材料可以是客体材料与主体材料掺杂混合物。其中,客体材料为发光材料,其包括 4-(二腈甲基)-2-丁基-6-(1,1,7,7-四甲基久洛呢啶-9-乙烯基)-4H-吡喃(DCJTb)、双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱(FLrpic)、双(4,6-二氟苯基吡啶)-四(1-吡啶基)硼酸合铱(FLIr6)、二(2-甲基-二苯基[f,h]喹啉)(乙酰丙酮)合铱(Ir(MDQ)2(acac))、三(1-苯基-异喹啉)合铱(Ir(piq)3)、三(2-苯基吡啶)合铱(Ir(ppy)3)中的至少一种;主体材料包括 4,4'-二(9-咔唑)联苯(CBP)、8-羟基喹啉铝(Alq_3)、1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯(TPBi)、N,N'-二苯基-N,N'-二(1-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺(NPB)中的至少一种。主、客体材料可以根据实际生产和应用

的需要进行灵活复合,且客体材料与主体材料的质量比可以为 1 ~ 10 :100。

[0036] 另外,该发光层 33 材料还可以选用荧光材料 4,4'-二(2,2-二苯乙烯基)-1,1'-联苯(DPVBi)、4,4'-双[4-(二对甲苯基氨基)苯乙炔基]联苯(DPAVBi)、5,6,11,12-四苯基萘并萘(Rubrene)、二甲基喹吡啶酮(DMQA)等材料中的至少一种。该发光层 33 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设置。

[0037] 上述电子传输层 34 材料可以是 2-(4-联苯基)-5-(4-叔丁基)苯基-1,3,4-噁二唑(PBD)、(8-羟基喹啉)-铝(Alq_3)、4,7-二苯基-邻菲咯啉(Bphen)、1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯(TPBi)、2,9-二甲基-4,7-联苯-1,10-邻二氮杂菲(BCP)、1,2,4-三唑衍生物(TAZ)中至少一种。当然,电子传输层 34 材料还可以是本领域公知的其他电子传输材料,其厚度也可以采用本领域常用的厚度。

[0038] 上述电子注入层 35 材料可以 LiF, CsF, NaF, MgF_2 等至少一种等碱金属的卤化物,当然,该电子注入层 35 材料还可以选用碘化锂、碘化钾、碘化钠、碘化铯、碘化铷中的至少一种等碱金属的卤化物。电子注入层 35 的厚度也可按照本领域常规的厚度进行设置。该电子注入层 35 的设置能有效增强其与阴极层 4 之间的欧姆接触,加强了导电性能,进一步提高阴极层 4 端的电子注入能力,以进一步平衡载流子,控制复合区域,在发光层中增加激子量,获得了理想的发光亮度和发光效率。正因如此,该电子注入层 35 也可以根据实际的需要不设置,也就是说,电子传输层 34 可以直接与阴极层 4 直接层叠结合。

[0039] 在进一步优选实施例中,在如图 1 所示的有机功能层 3 的基础上,上述有机功能层 3 还可以设置电子阻挡层 36 和空穴阻挡层 37,如图 2 所示。其中,该电子阻挡层 36 层叠结合在空穴传输层 32 与发光层 33 之间,空穴阻挡层 37 层叠结合在发光层 33 与电子传输层 34 之间。该电子阻挡层 36 的设置能将在发光层 33 中未形成激子的电子尽可能的阻挡截留在发光层 33 中,空穴阻挡层 37 的设置能将在发光层 33 中未形成激子的空穴尽可能的阻挡截留在发光层 33 中,以提高发光层 33 中的电子与空穴相遇机率,以提高两者复合而形成的激子量,并将激子能量传递给发光材料,从而激发发光材料的电子从基态跃迁到激发态,激发态能量通过辐射失活,产生光子,释放光能,以达到增强发光层 33 的发光强度的目的。当然,该电子阻挡层 36 和空穴阻挡层 37 可以根据实际生产的情况和应用的需要择一设置,其选用的材料和厚度可以按照本领域常用的材料和常规的厚度进行设置。

[0040] 上述阴极层 4 材料为 Ag、Al、Sm、Yb 中的任一种或两种以上的合金,其厚度为 18nm ~ 35nm。该优选的阴极材料以及厚度具有优异的光透过率,能有效提高该有机电致发光装置的出光率,另外,该优选的阴极材料导电性能优异。当然,该阴极层 4 的材料和厚度还可以是本领域常规的其他材料和厚度。

[0041] 由上述可知,上述有机电致发光装置通过将阳极设置成依次层叠结合的金属反射层 21、散射层 22、干涉层 23、半透金属层 24 结构,通过阳极层 2 的光反射抵消,从而有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率,提高了其的对比度。另外,通过选用金属反射层 21、散射层 22、干涉层 23、半透金属层 24 的材料和调节各层的厚度,特别是散射层 22、干涉层 23 的厚度和材料,实现两层的协同作用,能进一步降低上述有机电致发光装置的阴极对光的反射率,提高了其的对比度。

[0042] 相应地,上述实施例有机电致发光装置制备方法可以按照如图 3 所示的工艺流程制备,同时参见图 1 ~ 2,其制备方法包括如下步骤:

[0043] S01. 提供基板 1；

[0044] S02. 制备阳极层 2：在真空镀膜系统中，采用磁控溅射工艺，将金属反射层材料、散射层材料、干涉层材料、半透金属层材料依次溅射在步骤 S01 的基板 1 一表面制备依次层叠结合的金属反射层 21、散射层 22、干涉层 23 和半透金属层 24，形成阳极层 2；

[0045] S03. 制备有机功能层 3：在步骤 S02 制备阳极层 2 的与透光衬底层 1 相结合面相对的表面依次蒸镀空穴注入层材料、空穴传输层材料、发光层材料、电子传输层材料和电子注入层材料，分别制备空穴注入层 31、空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34、电子注入层 35，形成有机功能层 3；

[0046] S04. 制备阴极层 4：在真空镀膜系统中，在有机功能层 3 外表面阴极材料，形成阴极层 4。

[0047] 具体地，上述 S01 步骤中，基板 1 的结构、材料及规格如上文所述，为了篇幅，在此不再赘述。另外，在该 S01 步骤中，还包括对基板 1 的前期处理步骤，如清洗去污的步骤，具体清洗去污的步骤如下文实施例 1 的步骤 1。

[0048] 上述步骤 S02 中，溅射金属反射层 21、散射层 22、干涉层 23 和半透金属层 24 的工艺条件中，溅射各层时的基靶间距优选为 60mm，工作气体为氩气流量优选为 25sccm。具体地，在溅射金属反射层 21 时，以上文所述的金属反射层 21 金属材料作为靶材，溅射速度为 0.02 ~ 1nm/s；溅射散射层 22 时，同时以上文所述的散射层 22 透明导电氧化物和金属材料作为靶材，金属材质的溅射速度为 0.1 ~ 0.2nm/s，氧化物的溅射的速度为 0.5 ~ 1nm/s；溅射干涉层 23 时，以上文所述的干涉层 23 透明导电氧化物单独作为靶材，溅射速度为 0.1 ~ 0.5nm/s；溅射半透金属层 24 时，以上文所述的半透金属层 24 金属材料作为靶材，溅射速度为 0.02 ~ 0.1nm/s。溅射阳极层 2 中各层的溅射时间根据各层的厚度而定。

[0049] 上述步骤 S03 中，蒸镀空穴注入层 31、空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34、电子注入层 35 所选用的材料以及厚度均匀如上文所述。蒸镀各层所涉及到的工艺条件优选为真空沉积成膜的工作压强为 $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3}$ Pa，有机材料的蒸发速度为 0.01 ~ 1nm/s。

[0050] 当有机功能层 3 如上文所述，其包括依次层叠结合的空穴注入层 31、空穴传输层 32、电子阻挡层 36、发光层 33、空穴阻挡层 37、电子传输层 34、电子注入层 35 时，或者其包括依次层叠结合的空穴传输层 32、电子阻挡层 36、发光层 33、空穴阻挡层 37、电子传输层 34 时，或者其包括依次层叠结合的空穴传输层 32、发光层 33、电子传输层 34 时，制备有机功能层 3 的方法是在阳极层 2 外表面依次蒸镀该各层结构。

[0051] 上述步骤 S04 中，蒸镀阴极层 4 所用的阴极材料和制备得到的阴极层 4 的厚度均如上文所述，在此不再赘述。其蒸镀条件采用本领域常规的工艺条件即可，如金属的蒸镀速度优选为 0.2 ~ 2nm/s，真空沉积成膜的工作压强为 $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3}$ Pa。

[0052] 当然，还应当理解，关于本发明实施例有机电致发光装置的制备方法还应该包括该有机电致发光装置后续的封装方法。

[0053] 相应地，本发明实施例还提供了一种显示屏，其包括显示模块和用于控制显示模块的控制模块，当然还包括应用与显示屏的其他必要模块。其中，该显示模块中包括如上述的有机电致发光装置，具体地，在显示模块中，上文所述的有机电致发光装置按照矩阵排布。由于该显示屏含有上述有机电致发光装置，因此其具有高对比度，其显示画面清晰。

[0054] 相应地，本发明实施例进一步提供了一种设有显示屏的终端，该终端的显示屏为

上述含有有机电致发光装置的显示器。当然,应该理解,根据该终端的类型不同,该终端除了含有上文所述的显示屏之外,还含有其他必要模块或/和器件。因此,该终端可以是非便携式终端和便携式终端。非便携式终端可以是大型家电(如电视机、台式电脑显示器、设有显示屏的空调、洗衣机等)、工厂设有显示屏的机床等;便携式终端可以是手机、平板电脑、笔记本计算机、个人数字助理、游戏机和电子书等。这样,由于该终端的显示屏为上述含有有机电致发光装置的显示屏,因此电子器件的显示屏对比度高,画面清晰。

[0055] 当然,上文所述的有机电致发光装置还可以在特性照明领域中应用,如在要求反射率低的照明领域中应用。

[0056] 以下通过多个实施例来举例说明上述有机电致发光装置方面。

[0057] 实施例 1

[0058] 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Al(70nm)/ITO:Ni(10nm)/ITO(50nm)/Al(5nm)/空穴注入层(CuPc,10nm)/空穴传输层(NPB,30nm)/发光层(DPVBi,10nm)/电子传输层(TPBi,30nm)/电子注入层(LiF,0.5nm)/Ag(18nm)。其中,Al(70nm)/ITO:Ni(10nm)/ITO(50nm)/Al(5nm)构成阳极。

[0059] 其制备方法如下:

[0060] (1)将玻璃基板用清洗剂清洗,然后用蒸馏水,丙酮依次超声清洗;

[0061] (2)在真空度为 10^{-4} Pa的真空镀膜系统中,采用磁控溅射工艺,在玻璃基板表面制备阳极,其制备工艺参数中,基靶间距为60mm,工作气体为氩气流量为25sccm:

[0062] 首先制备反射金属层:以金属Al材料作为靶材,溅射速度为0.02nm/s,厚度为70nm;

[0063] 再制备散射层:先制备厚度10nm的散射层,其中金属材质为Ni,溅射速度为0.1nm/s,无机氧化物的材质为ITO靶材,溅射的速度为0.5nm/s;其中,在制备的散射层,该Ni的掺杂量占散射层总重量的16.7%;

[0064] 然后制备介质层:厚度为50nm,材质是ITO靶材,溅射速度为0.1nm/s;

[0065] 最后制备半反射金属层:材质为Al,厚度为5nm,溅射速度为0.02nm/s;

[0066] (3)在阳极表面蒸镀制备依次为空穴注入层,空穴传输层,发光层,电子传输层,电子注入层,形成有机功能层,材质依次为CuPc、NPB、DPVBi、TPBi、LiF,厚度依次为10nm、30nm、10nm、30nm、0.5nm;

[0067] (4)在有机功能层外表面制备Ag层形成阴极;厚度为18nm;

[0068] (5)制备完毕后,采用玻璃盖板进行封装。

[0069] 实施例 2

[0070] 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Ag(200nm)/IZO:Ag(20nm)/IZO(60nm)/Ag(7nm)/空穴注入层(ZnPc,15nm)/空穴传输层(TPD,30nm)/发光层(Ir(ppy)₃:TPBi(10%),10nm)/电子传输层(Bphen,40nm)/电子注入层(CsF,1nm)/Sm(35nm)。其中,Ag(200nm)/IZO:Ag(20nm)/IZO(60nm)/Ag(7nm)构成阳极。

[0071] 其制备方法如下:

[0072] (1)将玻璃基板用清洗剂清洗,然后用蒸馏水,丙酮依次超声清洗;

[0073] (2)在真空度为 10^{-4} Pa的真空镀膜系统中,采用磁控溅射工艺,在玻璃基板表面制

备阳极,其制备工艺参数中,基靶间距为 60mm,工作气体为氩气流量为 25sccm:

[0074] 首先制备反射金属层:以金属 Ag 材料作为靶材,溅射速度为 1nm/s,厚度为 200nm;

[0075] 再制备散射层:先制备厚度 20nm 的散射层,其中金属材质为 Ag,溅射速度为 0.15nm/s,无机氧化物的材质为 IZO 靶材,溅射的速度为 1nm/s;其中,在制备的散射层,该 Ag 的掺杂量占散射层总重量的 13.0%;

[0076] 然后制备介质层:厚度为 60nm,材质是 IZO 靶材,溅射速度为 0.05nm/s;

[0077] 最后制备半反射金属层:材质为 Ag,厚度为 7nm,溅射速度为 0.05nm/s;

[0078] (3) 在阳极表面蒸镀制备依次为空穴注入层,空穴传输层,发光层,电子传输层,电子注入层,形成有机功能层;

[0079] (4) 在有机功能层外表面制备 Sm 层形成阴极;厚度为 35nm;

[0080] (5) 制备完毕后,采用玻璃盖板进行封装。

[0081] 实施例 3

[0082] 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Au(100nm)/GZO:Pt(15nm)/GZO(60nm)/Au(10nm)/空穴注入层(TiOPc, 20nm)/空穴传输层(MeO-Sprio-TPD, 40nm)/发光层(DCJTb:Alq₃(1%), 15nm)/电子传输层(PBD, 50nm)/电子注入层(NaF, 0.8nm)/Yb(30nm)。其中,Au(100nm)/GZO:Pt(15nm)/GZO(60nm)/Au(10nm)构成阳极。

[0083] 其制备方法如下:

[0084] (1) 将玻璃基板用清洗剂清洗,然后用蒸馏水,丙酮依次超声清洗;

[0085] (2) 在真空度为 10⁻⁴Pa 的真空镀膜系统中,采用磁控溅射工艺,在玻璃基板表面制备阳极,其制备工艺参数中,基靶间距为 60mm,工作气体为氩气流量为 25sccm:

[0086] 首先制备反射金属层:以金属 Au 材料作为靶材,溅射速度为 0.5nm/s,厚度为 100nm;

[0087] 再制备散射层:先制备厚度 15nm 的散射层,其中金属材质为 Pt,溅射速度为 0.1nm/s,无机氧化物的材质为 GZO 靶材,溅射的速度为 1nm/s;其中,在制备的散射层,该 Pt 的掺杂量占散射层总重量的 9.1%;

[0088] 然后制备介质层:厚度为 60nm,材质是 GZO 靶材,溅射速度为 0.5nm/s;

[0089] 最后制备半反射金属层:材质为 Au,厚度为 10nm,溅射速度为 0.1nm/s;

[0090] (3) 在阳极表面蒸镀制备依次为空穴注入层,空穴传输层,发光层,电子传输层,电子注入层,形成有机功能层;

[0091] (4) 在有机功能层外表面制备 Yb 层形成阴极;厚度为 30nm;

[0092] (5) 制备完毕后,采用玻璃盖板进行封装。

[0093] 实施例 4

[0094] 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置,其结构为:玻璃基板/Cr(70nm)/AZO:Pt(10nm)/AZO(50nm)/Cr(5nm)/空穴注入层(VOPc, 15nm)/空穴传输层(MeO-TPD, 35nm)/发光层(Ir(piq)₃:NPB(10%), 12nm)/电子传输层(PBD, 40nm)/电子注入层(MgF₂, 0.5nm)/Ag(18nm)。其中,Cr(70nm)/AZO:Pt(10nm)/AZO(50nm)/Cr(5nm)构成阳极。

[0095] 其制备方法如下：

[0096] (1) 将玻璃基板用清洗剂清洗，然后用蒸馏水，丙酮依次超声清洗；

[0097] (2) 在真空度为 10^{-4} Pa 的真空镀膜系统中，采用磁控溅射工艺，在玻璃基板表面制备阳极，其制备工艺参数中，基靶间距为 60mm，工作气体为氩气流量为 25sccm；

[0098] 首先制备反射金属层：以金属 Cr 材料作为靶材，溅射速度为 0.02nm/s，厚度为 70nm；

[0099] 再制备散射层：先制备厚度 10nm 的散射层，其中金属材质为 Pt，溅射速度为 0.1nm/s，无机氧化物的材质为 AZO 靶材，溅射的速度为 0.5nm/s；其中，在制备的散射层，该 Pt 的掺杂量占散射层总重量的 16.7%；

[0100] 然后制备介质层：厚度为 50nm，材质是 AZO 靶材，溅射速度为 0.1nm/s；

[0101] 最后制备半反射金属层：材质为 Cr，厚度为 5nm，溅射速度为 0.02nm/s；

[0102] (3) 在阳极表面蒸镀制备依次为空穴注入层，空穴传输层，发光层，电子传输层，电子注入层，形成有机功能层；

[0103] (4) 在有机功能层外表面制备 Ag 层形成阴极；厚度为 18nm；

[0104] (5) 制备完毕后，采用玻璃盖板进行封装。

[0105] 实施例 5

[0106] 一种阳极具有低反射率的且阴极作为出光面的有机电致发光装置，其结构为：玻璃基板 /Ni (100nm) /ITO:Cu (10nm) /ITO (50nm) /Ni (5nm) /空穴注入层 (VOPc, 15nm) /空穴传输层 (MeO-TPD, 35nm) /发光层 (Ir (piq) 3:NPB (10%), 12nm) /电子传输层 (PBD, 40nm) /电子注入层 (MgF₂, 0.5nm) /Ag (18nm)。其中，Ni (100nm) /ITO:Cu (10nm) /ITO (50nm) /Ni (5nm) 构成阳极。

[0107] 其制备方法如下：

[0108] (1) 将玻璃基板用清洗剂清洗，然后用蒸馏水，丙酮依次超声清洗；

[0109] (2) 在真空度为 10^{-4} Pa 的真空镀膜系统中，采用磁控溅射工艺，在玻璃基板表面制备阳极，其制备工艺参数中，基靶间距为 60mm，工作气体为氩气流量为 25sccm；

[0110] 首先制备反射金属层：以金属 Ni 材料作为靶材，溅射速度为 0.02nm/s，厚度为 100nm；

[0111] 再制备散射层：先制备厚度 10nm 的散射层，其中金属材质为 Cu，溅射速度为 0.1nm/s，无机氧化物的材质为 ITO 靶材，溅射的速度为 0.5nm/s；其中，在制备的散射层，该 Cu 的掺杂量占散射层总重量的 16.7%；

[0112] 然后制备介质层：厚度为 50nm，材质是 ITO 靶材，溅射速度为 0.1nm/s；

[0113] 最后制备半反射金属层：材质为 Ni，厚度为 5nm，溅射速度为 0.02nm/s；

[0114] (3) 在阳极表面蒸镀制备依次为空穴注入层，空穴传输层，发光层，电子传输层，电子注入层，形成有机功能层；

[0115] (4) 在有机功能层外表面制备 Ag 层形成阴极；厚度为 18nm；

[0116] (5) 制备完毕后，采用玻璃盖板进行封装。

[0117] 对比实例 1

[0118] 一种阴极作为出光面的有机电致发光装置，其结构为：玻璃基板 /Ag (100nm) /空穴注入层 (CuPc, 10nm) /空穴传输层 (NPB, 30nm) /发光层 (DPVBi, 10nm) /电子传输层

(TPBi, 30nm)/ 电子注入层 (LiF, 0.5nm)/Ag(18nm)。其中, Ag(100nm) 为阳极。

[0119] 有机电致发光装置进行相关性能测试

[0120] 将上述实施例 1 至实施例 5 制备的有机电致发光装置和对比实例 1 中现有阳极结构的有机电致发光装置不点亮时进行反射率测试, 测试结果如下述表 1。

[0121] 表 1

[0122]

实施例	实施例 1	实施例 2	实施例 3	实施例 4	实施例 5	对比实例 1
反射率	18.3%	17.2%	16.9%	18.7%	15.9%	80.5%

[0123] 由上述表 1 可知, 上述实施例 1-5 中制备的有机电致发光装置由于采用金属反射层、散射层、干涉层、半透金属层构成黑阳极, 通过各层的协同作用, 使得金属反射层、半透金属反射光的相位相反, 达到干涉相消的效果, 有效减少了光总的反射, 实现低的反射率。特别是对散射层、干涉层厚度和材料进行调整能进一步降低上述有机电致发光装置的阳极对光的反射率, 提高了其的对比度。将实施例 1-5 制备的有机电致发光装置的反射率与对比实例 1 中有机电致发光装置相比, 实施例 1-5 制备的有机电致发光装置的反射率降低至 15.9%, 远远低于对比实例 1 中有机电致发光装置的反射率 80.5%。由此可知, 实施例 1-5 制备的有机电致发光装置作为显示屏时, 其对比度远远高于对比实例 1 中有机电致发光装置作为显示屏时的对比度。

[0124] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

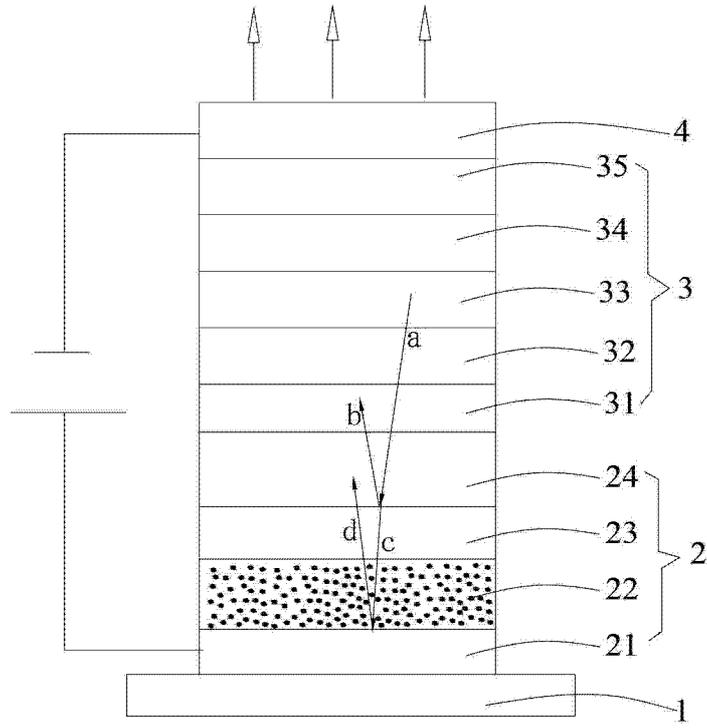


图 1

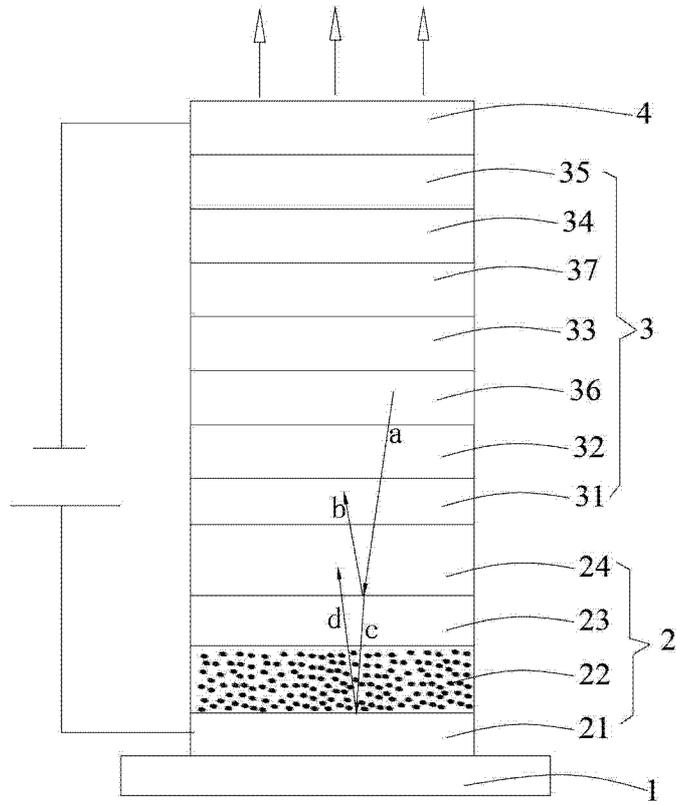


图 2

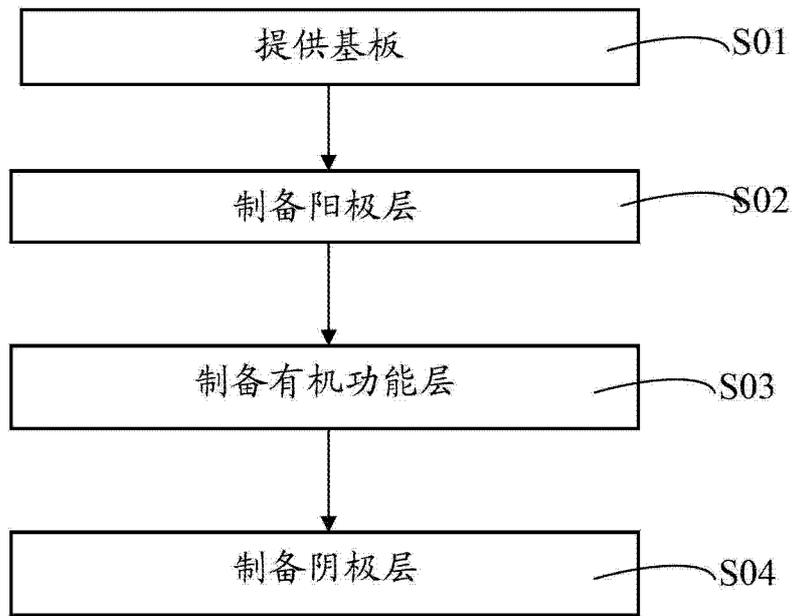


图 3

专利名称(译)	有机电致发光装置、显示屏及其终端		
公开(公告)号	CN104183720A	公开(公告)日	2014-12-03
申请号	CN201310193565.1	申请日	2013-05-22
[标]申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
[标]发明人	周明杰 冯小明 陈吉星 王平		
发明人	周明杰 冯小明 陈吉星 王平		
IPC分类号	H01L51/50 H01L51/52		
CPC分类号	H01L51/5012 H01L51/5268 H01L51/5271 H01L51/5275 H01L51/5281		
代理人(译)	张全文		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种有机电致发光装置、显示屏及其终端。该有机电致发光装置，包括依次层叠结合的基板、阳极层、有机功能层和作为出光面的阴极层，所述阳极层包括依次层叠结合的金属反射层、散射层、干涉层、半透金属层；其中，所述散射层材料包括透明导电氧化物和掺杂于所述透明导电氧化物中的金属粒子，所述干涉层材料为透明导电氧化物。本发明有机电致发光装置的阳极有效降低了该有机电致发光装置的阳极对光的反射率，提高了其的对比度。含有该有机电致发光装置的显示屏及其终端具有高对比度，其显示画面清晰。

